

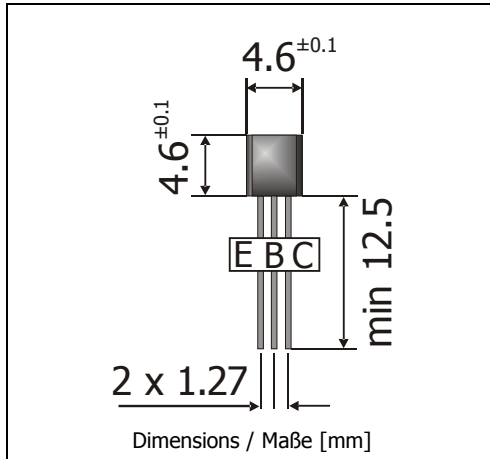
MPSA44-BK

NPN

High voltage Si-epitaxial planar transistors
Hochspannungs-Si-Epitaxial Planar-Transistoren

NPN

Version 2011-07-07



Power dissipation
Verlustleistung

625 mW

Plastic case
Kunststoffgehäuse

TO-92
(10D3)

Weight approx.
Gewicht ca.

0.18 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Special packaging bulk
Sonder-Lieferform Schüttgut



Maximum ratings (T_A = 25°C)

Grenzwerte (T_A = 25°C)

			MPSA44
Collector-Emitter-volt. - Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V _{CEO}	400 V
Collector-Base-voltage - Kollektor-Basis-Spannung	E open	V _{CBO}	500 V
Emitter-Base-voltage - Emitter-Basis-Spannung	C open	V _{EB0}	6 V
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}	625 mW ¹⁾
Collector current – Kollektorstrom (dc)		I _C	300 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T _j	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _S	-55...+150°C

Characteristics (T_j = 25°C)

Kennwerte (T_j = 25°C)

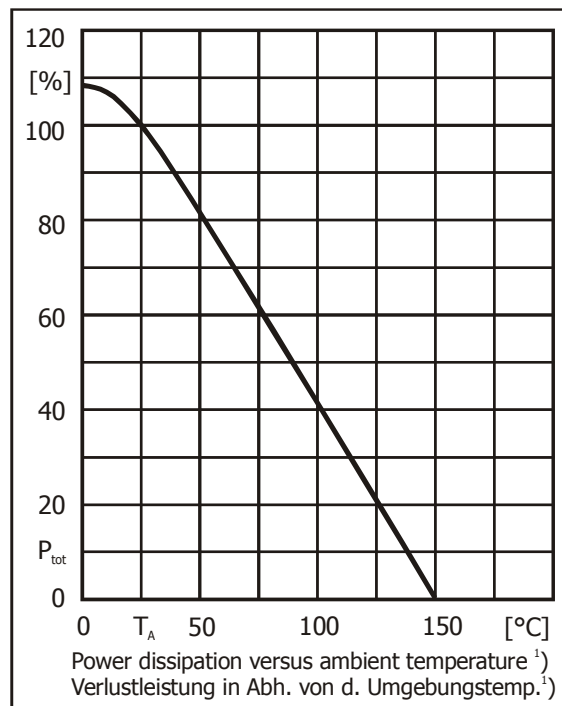
			Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom					
I _E = 0, V _{CB} = 400 V	MPSA44	I _{CB0}	–	–	100 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom					
I _B = 0, V _{EB} = 4 V	MPSA44	I _{EB0}	–	–	100 nA
Collector saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung ²⁾					
I _C = 1 mA, I _B = 0.1 mA	MPSA44	V _{CEsat}	–	–	400 mV
I _C = 10 mA, I _B = 1 mA		V _{CEsat}			500 mV
I _C = 50 mA, I _B = 5 mA		V _{CEsat}			750 mV

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case

Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

2 Tested with pulses t_p = 300 μs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%

Characteristics (T _j = 25°C)	Kennwerte (T _j = 25°C)				
	Min.	Typ.	Max.		
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung ¹⁾					
I _C = 10 mA, I _B = 1 mA	V _{BEsat}	–	–	750 mV	
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis					
V _{CE} = 10 V, I _C = 1 mA	h _{FE}	40	–	–	
V _{CE} = 10 V, I _C = 10 mA	h _{FE}	50	200	–	
V _{CE} = 10 V, I _C = 50 mA	h _{FE}	45	–	–	
V _{CE} = 10 V, I _C = 100 mA	h _{FE}	40	–	–	
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität					
V _{CB} = 20 V, I _E = i _e = 0, f = 1 MHz	MPSA44	C _{CB0}	–	–	7pF
Thermal resistance junction – ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R _{thA}	< 200 K/W ²⁾		
Recommended complementary PNP transistors Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren		MPSA94			



1 Tested with pulses t_p = 300 μs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case

Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden